

669.162.283: 541.412: 541.127.1: 669.5: 532.72

## (49) イオン拡散流間の連絡効果を考慮した金属酸化物間化合物の生成反応速度式

東京工業大学

○永田和宏、後藤和弘

[序]高炉内の亜鉛の循環はシャフト部低部の高温領域における耐火物損耗の重要な原因の一つである。著者らは前報<sup>(1)</sup>でこの損耗の原因のうち特に重要なZnO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>反応による固相間反応速度の測定結果を報告した。この反応機構でZnイオンの拡散が反応速度の律速になっていると仮定した場合Schmalzried<sup>(2)</sup>が提案した式に従って推算した速度定数は実測値から大きくずれる事を前報で指摘した。著者らはこのずれを生ずる原因がこの式でイオン拡散流間の連絡効果を無視している点であろうと考え、この効果を考慮したより厳密な反応速度式を導出したのでここに報告する。

[理論]固相反応による金属酸化物間化合物の生成反応AO<sub>x</sub>+mBO<sub>y</sub>=AB<sub>m</sub>O<sub>z</sub>を考える。この反応が生成層中のイオンの拡散に律速される場合反応速度定数は  $r=(\Delta x)^2/2V_m t$  で定義される。Δxは生成層の厚さ、V<sub>m</sub>はモル体積、tは時間である。この式を理論的に計算するために反応生成層と相境界で熱力学的な局部平衡が成立していると仮定する。等温では反応生成層中のイオンと電子の流量は現象方程式に従って全てのイオンと電子の電気化学ポテンシャル勾配の一次結合で表わされる。一方著者らはこれらの流量が電気的に中性な金属酸化物や金属の化学ポテンシャル勾配でも表わせる事を示した<sup>(3)</sup>。さて反応生成層中を1モルのAイオンとmモルのBイオンが相互に拡散するとそれぞれの相境界で1モルづつの化合物を生成する。この時電気的中性条件を満たすために酸素イオンと電子が拡散する場合もある。ゆえに成長速度は  $d(\Delta x)/dt=V_m |j_A-j_B/m|$  で与えられる。AイオンとBイオンの流量j<sub>A</sub>、j<sub>B</sub>に前述の式を代入し、生成層の一方の端から他方の端まで積分すると生成反応速度定数の厳密な式を得る。

$$r = \left| \int_{\mu_{AO}}^{\mu_{AO}^{eq}} \left( T_{AA} - \frac{2}{m} T_{AB} + \frac{1}{m^2} T_{BB} \right) d\mu_{AO} \right| \quad \dots (1) \text{式} \quad \text{ここで } T_{ik} = L_{ik} - (1/S) \sum_k Z_k L_{ik} \sum_p Z_p L_{ik}, S = \sum_i Z_i Z_k L_{ik} \\ (i, k, i', k' = A, B, O, e), Z_i \text{ は } i \text{ 種イオンの電価数。}$$

L<sub>ik</sub>は現象係数でOnsagerの相反定理  $L_{ik} = L_{ki}$  と  $L_{ii} L_{kk} \equiv L_{kk}^2$  を満足する。著者らは文献3でこれらの現象係数とトレーーサー拡散係数D<sup>tr</sup>、電導度および輸率t<sub>i</sub>の間の関係式を得ている。ゆえにこれらの物性値からL<sub>ik</sub>の値を知ればrが計算できる。次に反応生成層がイオン伝導体である場合の一つの式を示す。

$$r = \left| \int_{\mu_{AO}}^{\mu_{AO}^{eq}} \left( 1 + \frac{Z_A}{m Z_B} \right)^2 \left( \frac{C_A}{RT} D_A^{tr} - \frac{J}{F^2 Z_A^2} t_A^2 \sigma \right) d\mu_{AO} \right| \quad \dots (2) \text{式} \quad \text{ここで } F \text{ は ファラデー定数 (96500 C - ロン/当量) } \\ J \text{ は ジュール係数 (4.184) である。}$$

[推算値と実測値の比較] ZnAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>スピネルはイオン伝導体である事が確かめたので(2)式を用いてrを計算した。本研究で伝導度と輸率を測定し、拡散係数および積分の結果必要なスピネルの生成自由エネルギーの値は文献より求めた。図1に計算結果を示す。図に示すようにSchmalzriedの式による推算値が実測値<sup>(1)</sup>よりも大きいのに對し、(2)式による結果は実測値によい一致を示した。

[考察] Schmalzriedの式はイオン伝導体を生成する反応には有効でないがCr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>系スピネルの様な電子伝導体を生成する反応には有効である。すなむろ反応生成物がイオン伝導体の時はイオン拡散流間の連絡効果を無視できないが、電子伝導体の場合には無視する事ができる。

[参考文献] (1)佐藤、後藤：鉄と鋼, 64(1978)S 496, (2)H.Schmalzried

: Z.Physik.Chem., NF, 33(1962) p 111, (3)K.Nagata and K.S.Goto: J.Electrochem. Soc., 123(1976) p 1814

